

1. 主要用途

主要用于开关模式电源和高频 DC-DC 转换器

2. 主要特点

- 开关速度快、开关损耗小
- 正向压降低、传导损耗小

3. 封装外形

TO-3PB (符合 RoHS 指令要求)

4. 电特性

4.1 极限值

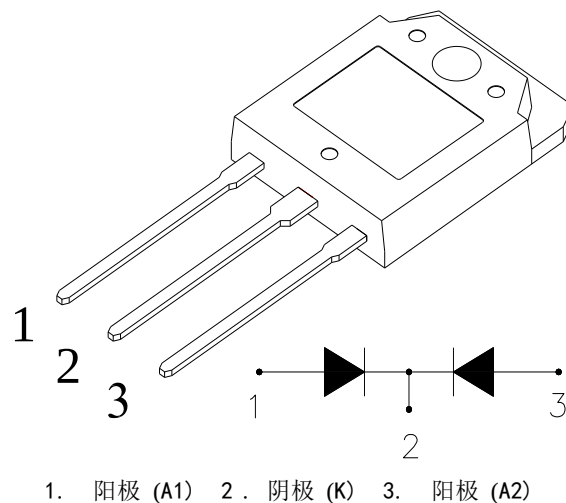
除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参 数 名 称	符 号	额 定 值	单 位
反向重复峰值电压	V_{RRM}	200	V
平均正向电流	$I_{F(AV)}$	15×2	A
正向不重复峰值电流	I_{FSM}	280	A
耗散功率	P_c	100	W
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度	T_{stg}	$-55\sim 150$	$^{\circ}\text{C}$

4.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件	规 范 值			单 位
			最小	典型	最大	
反向重复峰值电压	V_{RRM}	$I_R=1\text{mA}$	200			V
正向电压	V_F	$I_F=15\text{A}$			0.90	V
		$I_F=30\text{A}$			1.05	V
反向电流	I_R	$V_R=200\text{V}, T=25^{\circ}\text{C}$			10	μA
电容	C_d	$f=1\text{MHz}; V_R=4\text{V}$		150		pF



5. 特性曲线

图 1. Typical Forward Voltage Characteristics (per diode)

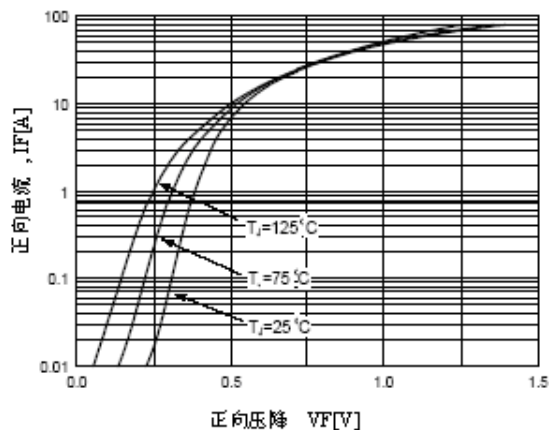


图 2. Typical Reverse Current vs. Reverse Voltage (per diode)

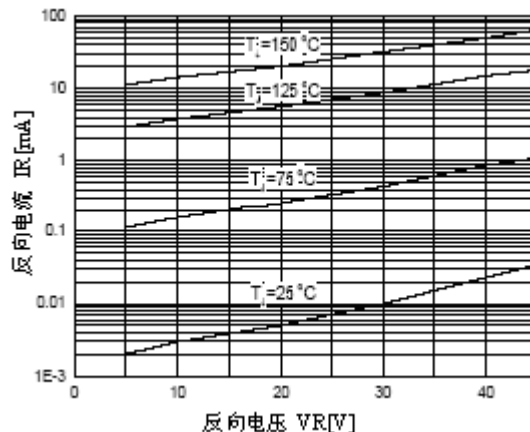


图 3. Typical Junction Capacitance (per diode)

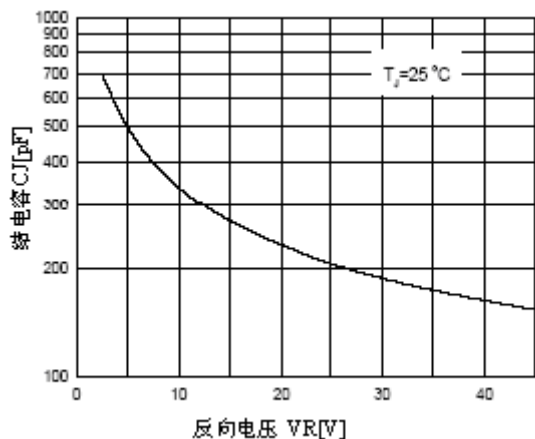


图 4. Thermal Impedance Characteristics (per diode)

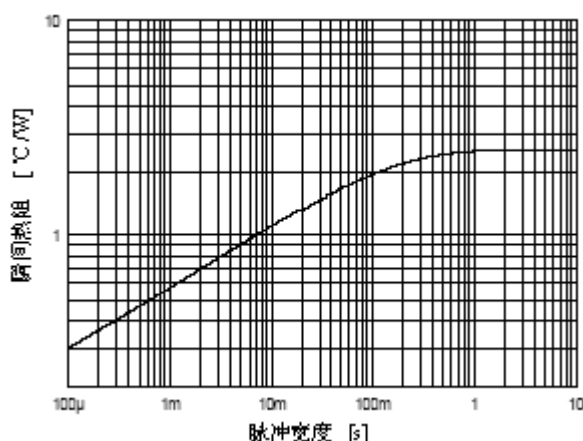


图 5. Forward Current Derating Curve

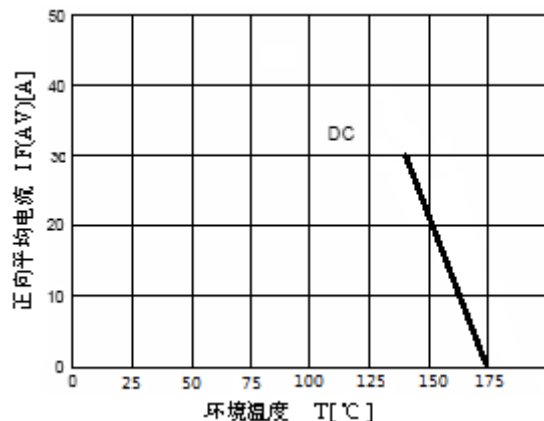
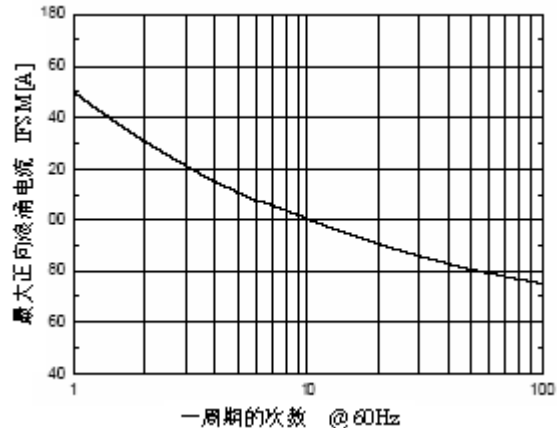
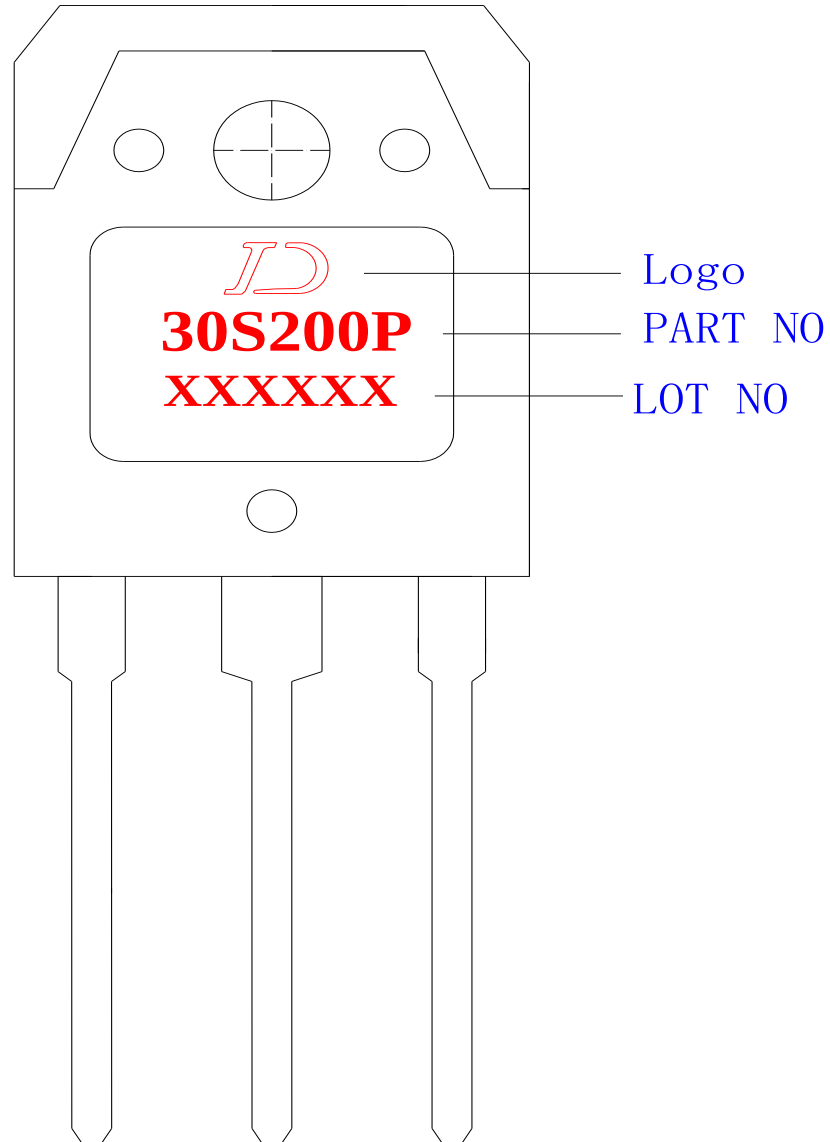


图 6. Non-Repetitive Surge Current(per diode)



6. Marking (印章说明)





肖特基势垒二极管

T0-3PB

